

三菱半導体<トランジスタ>  
**2SA1282, 2SA1282A**

低周波電力増幅用  
 シリコンPNPエピタキシャル形

**概要**

2SA1282, 2SA1282Aは、樹脂封止形シリコンPNPエピタキシャル形トランジスタです。コレクタ損失が大きく、特にコレクタ電流を大きく、設計、製造されていますので、小形モータドライブ、ソレノイドドライブ、電源用として最適です。

2SC3242、2SC3242Aとコンプリメンタリです。

**特長**

- コレクタ電流が大きい  $I_C = -2A$
- $V_{CE(sat)}$ が低い  $I_C = -1A$ で、 $V_{CE(sat)} = -0.17V$ 標準
- $h_{FE}$ が高い  $h_{FE} = 150 \sim 800$
- コレクタ損失が大きい  $P_C = 900mW$

**用途**

VTR、デッキ、プレーヤー等の小形モータドライブ、メカコン  
 トロール系（ソレノイドドライブ）、電源

**最大定格 ( $T_a = 25^\circ C$ )**

記号	項目	定格値		単位
		2SA1282	2SA1282A	
$V_{CB0}$	コレクタ・ベース間電圧	-20	-20	V
$V_{EB0}$	エミッタ・ベース間電圧	-6	-6	V
$V_{CE0}$	コレクタ・エミッタ間電圧	-16	-20	V
$I_{CM}$	せん頭コレクタ電流	-3		A
$I_C$	コレクタ電流	-2		A
$P_C$	コレクタ損失	900		mW
$T_J$	接合部温度	+150		$^\circ C$
$T_{stg}$	保存温度	-55 ~ +150		$^\circ C$

**電気的特性 ( $T_a = 25^\circ C$ )**

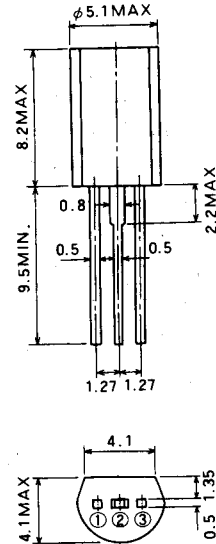
記号	項目	測定条件	特性値						単位
			2SA1282			2SA1282A			
			最小	標準	最大	最小	標準	最大	
$V_{(BR)CB0}$	コレクタ・ベース降伏電圧	$I_C = -10\mu A, I_E = 0$	-20			-20			V
$V_{(BR)EB0}$	エミッタ・ベース降伏電圧	$I_E = -10\mu A, I_C = 0$	-6			-6			V
$V_{(BR)CE0}$	コレクタ・エミッタ降伏電圧	$I_C = -2mA, R_{BE} = \infty$	-16			-20			V
$I_{CB0}$	コレクタしゃ断電流	$V_{CB} = -16V, I_E = 0$			-0.2			-0.2	$\mu A$
$I_{EB0}$	エミッタしゃ断電流	$V_{EB} = -4V, I_C = 0$			-0.2			-0.2	$\mu A$
$h_{FE} \uparrow$	直流電流増幅率	$V_{CE} = -4V, I_C = -100mA$	150		800	150		500	—
$V_{CE(sat)}$	コレクタ・エミッタ飽和電圧	$I_C = -1A, I_B = -50mA$	-0.17	-0.3		-0.17	-0.3		V
$f_T$	利得帯域幅積	$V_{CE} = -2V, I_E = 10mA$	80			80			MHz
$G_{ob}$	コレクタ出力容量	$V_{CB} = -10V, I_E = 0, f = 1MHz$	42			42			

†:  $h_{FE}$ の値により右表のようにアイテム分類を行っています。

アイテム	E	F	G
$h_{FE}$	150 ~ 300	250 ~ 500	400 ~ 800

**外形図**

単位: mm



**電極接続**

- ①: エミッタ EIAJ: -
- ②: コレクタ JEDEC: -
- ③: ベース

(注1) 公差指定のない寸法は代表値を示す。